

TechniStrip® MLO 07

Photoresist Stripper



先进、高性能 DMSO 基础剥离剂

曾经，NMP 溶剂因其强大的剥离性能，被广泛应用于光刻胶去除和金属剥离；但随着国际 EH&S 修订，将其标记为生殖毒性物质，因此，许多公司正在寻找传统 NMP 剥离工艺的替代品。

Technic 研发且表明，以 DMSO 为基础专有配方的剥离剂为提供等效、甚至更优于 NMP 性能的最佳选择产品。

TechniStrip® MLO07 是一款强大的 DMSO 基础剥离剂，除低毒性外，还具备诸多优于 NMP 的性能。

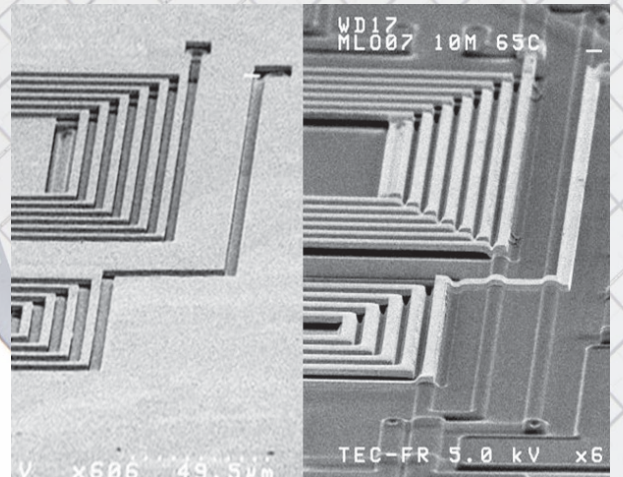
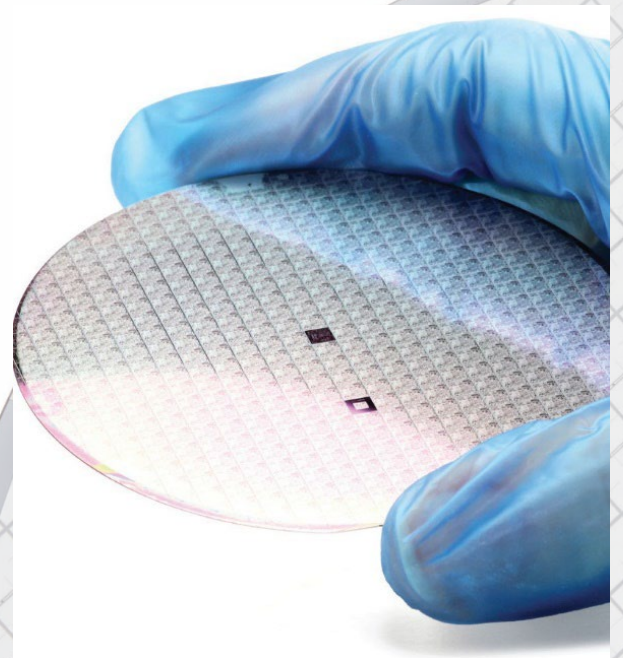
该独特的化学试剂适用于金属剥离应用，可用于难以蚀刻或惰性金属，如：黄金。

特性

- 性能优于 NMP
- 可溶解许多正型光刻胶
- 对于铜、锡、银、铝、磁性合金及有机基材具有高兼容性
- 非常适合应用于金或其它贵金属剥离
- 剥离过程中降低金属碎片形成

优点

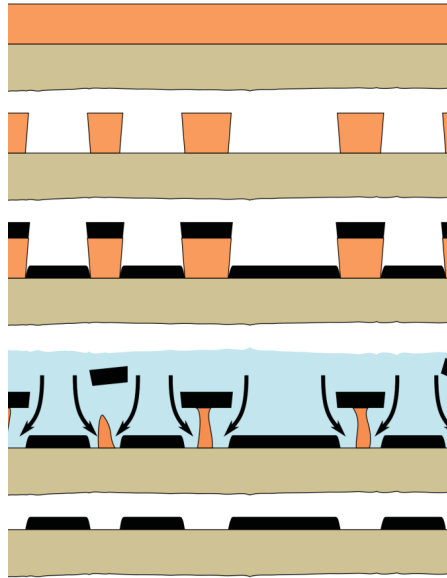
- 本品通过工艺改进及延长溶液寿命，降低操作成本
- 不同于 NMP 溶剂，本品无刺激性气体排放
- 可溶解多种抗蚀剂、降低剥离过程中金属碎片形成，减少工艺缺陷
- 高材料兼容性、操作窗口宽、操作简单
- 不含 NMP 和 TMAH 配方，操作安全性高



TechniStrip® MLO 07 先進 DMSO 光阻剝離劑

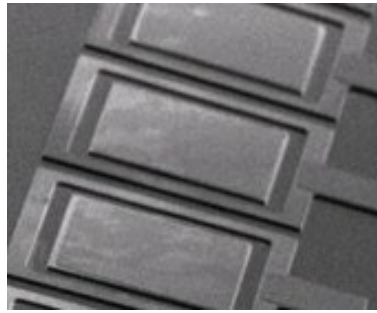
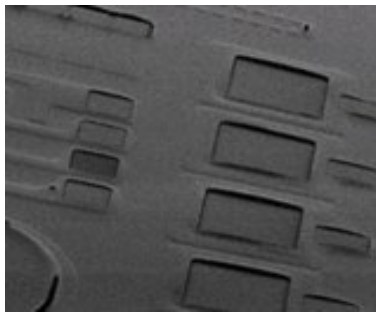
金属剝離程序

1. 涂有阻剂的基材
2. 顯影阻剂, 以获得理想图案
3. 在整个晶圆上溅射或蒸发金属
4. 使用TechniStrip® MLO 07去除阻剂, 剝離“多余”金属
5. 获得所需图案

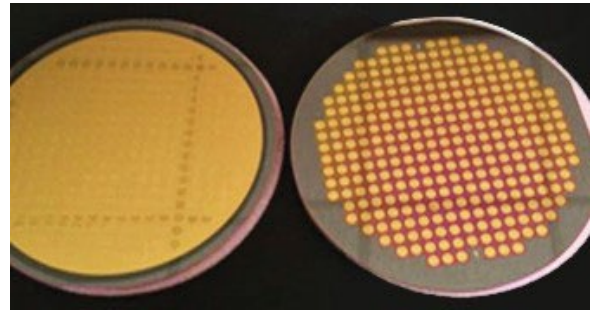


The low etch rate properties of TechniStrip® MLO 07 enables compatible photoresist stripping with many different material stacks.

蚀刻 (静态浸泡)	
基底	(Å/min @ 65°C)
Al (5% Cu)	< 2
Cu (PVD)	< 2
Cu (ECD)	< 2
Ni	< 1
Ta/TaN	< 1
Ti/TiN/TiW	< 1
Au, Sn, Ag	< 1
Thermal SiO ₂	< 1
Undoped Si	< 1

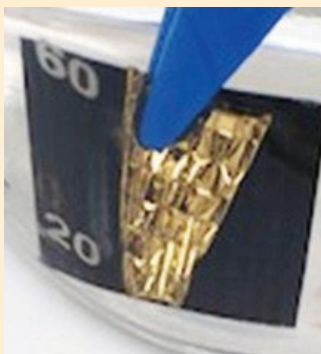


剝離銀前后状态

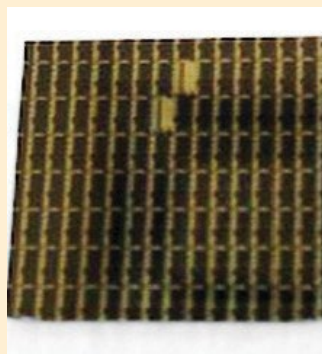


剝離金前后状态

TechniStrip® MLO 07
14 minutes @ 65°C

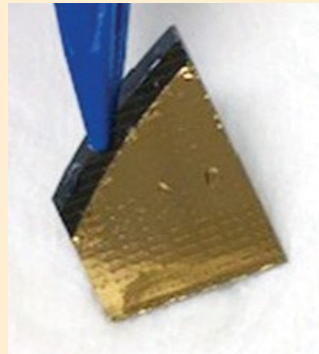


清洗前

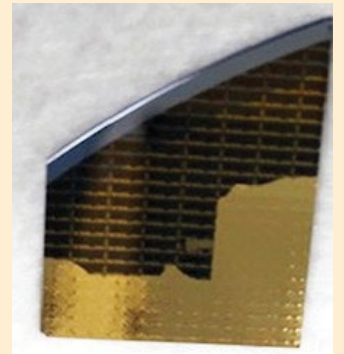


终品

NMP
90 minutes @ 65°C



清洗前



终品



www.technic.com